

**ПЕРСОНАЛИЯ****Памяти Василия Ивановича Швейкина****(4 февраля 1935 г. – 4 января 2018 г.)**

4 января 2018 г. после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Василий Иванович Швейкин – родоначальник направления полупроводниковых лазеров в АО «НИИ “Полус” им. М.Ф.Степльмаха», доктор технических наук, профессор, лауреат Ленинской премии.

Василий Иванович Швейкин родился в Москве. В июне 1958 года он окончил физфак МГУ и поступил в аспирантуру, а в 1961 г., успешно защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, стал младшим научным сотрудником физфака МГУ. С октября 1962 г. В.И.Швейкин – сотрудник НИИ «Полус», где он проработал более 40 лет.

В.И.Швейкин стоял у истоков создания полупроводниковых лазеров в СССР. В марте 1963 г. (через 1 год после образования НИИ «Полус») под его руководством и при непосредственном участии в институте была получена генерация в инжекционном полупроводниковом лазере на арсениде галлия.

В 1965 г. в НИИ «Полус» был создан первый промышленный лазерный диод ЛД-1 и полупроводниковый квантовый генератор «Комета», главным конструктором которых был В.И.Швейкин.

Вся трудовая деятельность Василия Ивановича была связана с «Полусом». Он прошел длинный путь – от начальника лаборатории (1963 г.) до главного научного сотрудника (2001 г.). Под руководством В.И.Швейкина были заложены основы базовых технологических процессов про-

изводства полупроводниковых лазеров, создана линейка технологического оборудования для получения планарных гетероструктур и разработаны технологии их превращения в конкретные изделия. С 1978 по 1990 гг. Василий Иванович – Главный конструктор направления полупроводниковых лазеров Министерства электронной промышленности СССР.

В.И.Швейкин – создатель научной школы по разработке технологии изготовления полупроводниковых лазеров. Под его руководством защищены 21 кандидатская и 3 докторские диссертации, двое из его учеников впоследствии стали лауреатами Государственных премий СССР в области полупроводниковых лазерных технологий. Василий Иванович – основатель базовой кафедры МИРЭА при НИИ «Полус» и ее первый заведующий, действительный член Академии инженерных наук, автор более 170 научных трудов, ему принадлежат более 100 авторских свидетельств и патентов.

В.И.Швейкин вырастил плеяду ученых, инженеров, технологов и конструкторов. Им и его сотрудниками в НИИ «Полус» разработаны сотни полупроводниковых лазеров различного назначения. Под его руководством впервые в СССР был создан и запущен в серийное производство целый ряд полупроводниковых лазеров и излучателей.

Активное участие В.И.Швейкин принимал в выполнении ряда целевых программ по направлению «Полупроводниковые лазеры», одним из крупных результатов которых стало решение сложной проблемы долговечности полупроводниковых лазеров. Срок службы непрерывных лазеров, предназначенных для волоконно-оптических систем связи, был увеличен с единиц до сотен тысяч часов.

За разработку и освоение полупроводниковых лазеров Василию Ивановичу в составе авторского коллектива в 1972 г. была присуждена Ленинская премия. За большой вклад в развитие полупроводниковой квантовой электроники В.И.Швейкин награжден орденом Трудового Красного знамени и медалями.

Светлая память о Василии Ивановиче Швейкине, родоначальнике направления полупроводниковых лазеров в НИИ «Полус», идеологе и организаторе разработок серийных полупроводниковых лазерных приборов и их технологий, создателе научной школы в области технологии изготовления полупроводниковых лазеров, сохранится в сердцах его коллег, соратников и учеников, использующих и развивающих его достижения.

**О.Н.Крохин, Ю.В.Гуляев, А.С.Сигов,  
И.А.Щербаков, М.Г.Васильев, В.П.Дураев,  
А.Г.Забродский, Г.М.Зверев, И.Б.Ковш,  
Ю.А.Кротов, Е.В.Кузнецов, А.А.Мармалюк,  
Ю.М.Попов, А.С.Семенов, В.А.Симаков**